

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.....



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ☒; Nội dung không đúng thì để trống: ☐)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ☒; Giảng viên thỉnh giảng ☐

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Vật lý chất rắn

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Bùi Nguyên Quốc Trinh

2. Ngày tháng năm sinh: 09/09/1980; Nam ☒; Nữ ☐; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ☐

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Phòng 906, Toà nhà N5A, Trung Hoà-Nhân Chính, Hoàng Đạo Thuý, Thanh Xuân, Hà Nội

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bru điện): Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phòng 503 (Chương trình Công nghệ nano), Cơ sở Mỹ Đình, đường Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại nhà riêng: 02435527380; Điện thoại di động: 0914091206;

E-mail: trnhbnq@vnu.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ năm 2004 đến năm 2007: Nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến, Nhật Bản

Từ năm 2007 đến năm 2008: Nghiên cứu viên sau tiến sĩ (post doc) tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến, Nhật Bản

Từ năm 2008 đến năm 2012: Nghiên cứu viên sau tiến sĩ toàn thời gian (Full-time post-doc researcher) tại Cơ quan Khoa học và Công nghệ, Nhật Bản

Từ năm 2012 đến năm 2019: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Chức vụ: Hiện nay: Giảng viên cơ hữu; Chức vụ cao nhất đã qua: Giảng viên cơ hữu

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ cơ quan: Phòng 503 (Chương trình Công nghệ nano), Cơ sở Mỹ Đình, đường Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 02473066001

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): - Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN: Học kỳ 2 năm học 2016-2017; và từ 02/2018 đến 07/2018. - Đại học Công nghệ, ĐHQGHN: từ 21/01/2019 đến 16/06/2019; từ 28/08/2019 đến 05/01/2020; và từ 02/03/2020 đến 12/07/2020. - Khoa Quốc tế, ĐHQGHN: từ 03/09/2019 đến 05/02/2

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): đang công tác tại Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH ngày 25 tháng 06 năm 2002, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý chất rắn

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

- Được cấp bằng ThS ngày 15 tháng 03 năm 2005, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý chất rắn

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

- Được cấp bằng TS ngày 21 tháng 09 năm 2007, ngành: Khoa học Vật liệu, chuyên ngành: Vật lý bán dẫn

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến, Nhật Bản

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Chế tạo các màng mỏng sắt điện có độ phân cực dư lớn, dòng rò nhỏ và điện trường kháng điện nhỏ, ứng dụng cho chế tạo bộ nhớ sắt điện không tự xoá.

- Chế tạo các màng mỏng điện môi, màng mỏng ô-xít bán dẫn bằng phương pháp “phi chân không”, ứng dụng cho transistor đóng/mở trong hiển thị cong (flexible display).

- Phát triển công nghệ in khắc “phi chân không”, để tạo hình và chế tạo các linh kiện điện tử có cấu trúc nano và pin mặt trời.

- Phát triển vật liệu ô-xít bán dẫn loại p mới, thân thiện với môi trường, định hướng “phi silic” và thay thế vật liệu hữu cơ, trong cấu trúc inverter của mạch điện logic.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 2 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 6 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai);

- Đã hoàn thành 1 đề tài NCKH cấp Bộ;

- Đã công bố (số lượng) 37 bài báo KH, trong đó 21 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 3 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 0, trong đó 0 thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng 0 tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
Không có			

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá):

Trên cương vị là giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi tự nhận thấy mình có đủ các tiêu chuẩn của một nhà giáo, cụ thể:

- Luôn có thái độ chính trị đúng đắn.
- Sống và làm việc theo pháp luật; nghiêm túc chấp hành đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Luôn gương mẫu và có tư cách đúng đắn trước người học.
- Luôn tận tâm làm việc, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Về nhiệm vụ, tôi đã thực hiện tốt các nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu khoa học, luôn tìm cách tự nâng cao trình độ, và cộng tác với đồng nghiệp trong và ngoài nước.

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên *:

- Tổng số 8 năm.
- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ

(Căn cứ chế độ làm việc đối với giảng viên theo quy định hiện hành)

--

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đề án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số lượng giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ giảng trực tiếp/Số giờ quy đổi/Số giờ định mức
		Chính	Phụ			ĐH	SDH	
1	2013-2014	2			3	148.85	45	193.85/282.85/280
2	2014-2015	2			2	171.5	79.5	251.50/326.16/280
3	2015-2016	2		1	2	341.9	30	371.90/502.89/270
3 năm học cuối								
4	2017-2018			2	3	194.33	14	208.33/368.19/270
5	2018-2019			1	1	284.65	15	299.65/415.15/270
6	2019-2020					257.65	45	302.65/370.15/270

() - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.*

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài ☒:

- Học ĐH ☐; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS ☐ hoặc luận án TS ☒ hoặc TSKH ☐; Tại nước: Nhật Bản năm 2007

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước ☐:

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài ☒:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): 1. Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội. 2. Trường Đại học Khoa

học và Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 3. Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. 4. Đại học Quốc gia Thành công, Đài Loan.

d) Đối tượng khác ☐; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Bằng Tiến sĩ

4. Hướng dẫn NCS, học viên CH, BSCK, BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			
1	Đỗ Hồng Minh	X		X		01/2013 đến 01/2016	Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội	08/01/2020
2	Nguyễn Quang Hoà	X		X		12/2013 đến 12/2016	Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội	12/06/2020

3	Nguyễn Huy Tiếp		X	X		11/2012 đến 07/2013	Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội	24/10/2013
4	Vũ Thị Huyền Trang		X	X		04/2015 đến 04/2016	Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội	28/03/2016
5	Trần Văn Dũng		X	X		11/2015 đến 06/2017	Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội	28/06/2017

6	Nguyễn Văn Lợi		X		X	04/2017 đến 04/2018	Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội	10/04/2018
7	Nguyễn Văn Dũng		X		X	12/2017 đến 07/2018	Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội	16/07/2018
8	Lê Thị Hiền		X		X	12/2018 đến 07/2019	Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội	15/07/2019

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai số lượng NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDĐH (số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Không có							

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS/TS: 0

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	Nghiên cứu cấu trúc lai hoá LaTaO/PZT cho lớp điện môi làm cổng trong transistor dạng màng mỏng chế tạo bằng phương pháp dung dịch	CN	QG.14.08, cấp Bộ	22/04/2014 đến 23/04/2016	Ngày 15/09/2016, xếp loại: Tốt

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;

Các chữ viết tắt:

CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)

7.1. Bài báo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
1	Spin Reorientation in ErCo _{10-x} FexMo ₂ Compounds	4	Không	Physica B: Condensed Matter (ISSN: 0921-4526)	Q2, H-index: 105 - SCI IF: 1.874		327 , 262-265	2003
2	Control of Preferential Orientation of Platinum Films on RuO ₂ /SiO ₂ /Si Substrates by Sputtering	2	Có	Japanese Journal of Applied Physics (ISSN: 0021-4922)	Q1, H-index: 122 - SCI IF: 1.471		45 , 8810-8816	2006
3	Operation of Ferroelectric Gate Field-Effect Transistor Memory with Intermediate Electrode using Polycrystalline Capacitor and Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effect Transistor	2	Có	Japanese Journal of Applied Physics (ISSN: 0021-4922)	Q1, H-index: 122 - SCI IF: 1.471	4	45 , 7341–7344	2006

4	Platinum Magneto-sputtered Films used as Electrodes to Measuring Conductivity of Solutions	3	Không	VNU Journal of Science: Mathematics-Physics (ISSN: 0866-8612)			14 , 90-94	2003
5	Preparing and Studying Thermo-electric Properties of the Flash-evaporated P-type Bi _{0.4} Sb _{1.6} Te ₃ Thin Films	3	Không	VNU Journal of Science: Mathematics-Physics (ISSN: 0866-8612)			14 , 95-100	2003
6	Fabrication of Polycrystalline Ferroelectric Gate FET Memory with an Intermediate Electrode	2	Có	IEEE Proceedings of 15th International Symposium on the Applications of Ferroelectrics (ISBN: 9781424413317)		1	, 77-80	2006
7	Improvement of Nondestructive Readout of Ferroelectric Gate FET Memory with an Intermediate Electrode by using New Data Writing and Reading Methods	2	Có	IEEE Proceedings of 16th International Symposium on the Applications of Ferroelectrics (ISBN: 9781424413331)		1	, 58-61	2007
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
8	Nondestructive Readout of Ferroelectric-Gate Field-Effect Transistor Memory With an Intermediate Electrode by Using an Improved Operation Method	2	Có	IEEE Transactions on Electron Devices (ISSN: 0018-9383)	Q1, H-index: 176 - SCI IF: 2.704	2	55 , 3200-3207	2008

9	Disturb-Free Writing Operation for Ferroelectric-Gate Field-Effect Transistor Memories With Intermediate Electrodes	2	Không	IEEE Transactions on Electron Devices (ISSN: 0018-9383)	Q1, H-index: 176 - SCI IF: 2.704		56 , 3090-3096	2009
10	Synthesis of undoped and M-doped ZnO (M = Co, Mn) nanopowder in water using microwave irradiation	6	Không	Journal of Physics: Conference Series (ISSN: 1742-6588)	Q3, H-index: 70 - Scopus	17	187 , 012020	2009
11	A low-temperature crystallization path for device-quality ferroelectric films	8	Không	Applied Physics Letters (ISSN: 0003-6951)	Q1, H-index: 423 - SCI IF: 3.521	36	97 , 102905	2010
12	Totally solution-processed ferroelectric-gate thin-film transistor	7	Có	Applied Physics Letters (ISSN: 0003-6951)	Q1, H-index: 423 - SCI IF: 3.521	38	97 , 173509	2010
13	Optimization of Pt and PZT Films for Ferroelectric-Gate Thin Film Transistors	6	Không	Ferroelectrics (ISSN: 0015-0193)	Q3, H-index: 54 - SCIE IF: 0.697	14	405 , 281–291	2010
14	Ferroelectric-Gate Thin-Film Transistor Fabricated by Total Solution Deposition Process	7	Không	Japanese Journal of Applied Physics (ISSN: 0021-4922)	Q1, H-index: 122 - SCI IF: 1.471	24	50 , 04DD09-1–04DD09-6	2011

15	Electric Properties and Interface Charge Trap Density of Ferroelectric Gate Thin Film Transistor Using (Bi,Lu)4Ti3O12/Pb(Zr,Ti)O3 Stacked Gate Insulator	6	Có	Japanese Journal of Applied Physics (ISSN: 0021-4922)	Q1, H-index: 122 - SCI IF: 1.471	4	51 , 09LA09	2012
16	Interface Charge Trap Density of Solution Processed Ferroelectric Gate Thin Film Transistor Using ITO/PZT/Pt Structure	6	Không	Ferroelectrics Letters Section (ISSN: 0731-5171)	Q4, H-index: 17 - SCIE IF: 0.563	7	40 , 17–29	2013
17	Switchable Voltage Control of the Magnetic Anisotropy in Heterostructured Nanocomposites of CoFe/NiFe/PZT	7	Không	Journal of the Korean Physical Society (ISSN: 0374-4884)	Q3, H-index: 44 - SCIE IF: 0.63	2	63 , 812-816	2013
18	Fabrication of 120 nm Channel Length Ferroelectric Gate Thin-Film Transistor by Nano-imprinting Lithography	5	Không	Japanese Journal of Applied Physics (ISSN: 0021-4922)	Q1, H-index: 122 - SCI IF: 1.471	4	53 , 02BC14-1	2014
19	Sub-100 nm Ferroelectric-Gate Thin-Film Transistor with Low-Temperature PZT Fabricated on SiO2/Si Substrate	2	Có	Ferroelectrics Letters Section (ISSN: 0731-5171)	Q4, H-index: 17 - SCIE IF: 0.563	1	42 , 65–74	2015

20	Low-temperature PZT thin-film ferroelectric memories fabricated on SiO ₂ /Si and glass substrates	4	Có	Journal of Science: Advanced Materials and Devices (ISSN: 2468-2284)	Q1, H-index: 17 - ISI	16	1 , 75-79	2016
21	Solution-processed CuO thin films with various Cu ²⁺ ion concentrations	4	Có	Thin Solid Films (ISSN: 0040-6090)	Q2, H-index: 184 - SCI IF: 1.888	3	660 , 819-823	2018
22	Si-doping effect on solution-processed In-O thin-film transistors	8	Không	Materials Research Express (ISSN: 2053-1591)	Q2, H-index: 27 - SCIE IF: 1.449	4	6 , 026410 (1-9)	2019
23	Silicon-doped indium oxide – a promising amorphous oxide semiconductor material for thin-film transistor fabricated by spin coating method	8	Không	IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (ISSN: 1757-8981)	H-index: 31 - Scopus	1	625 , 012002	2019
24	Solution processed In-Si-O thin film transistors on hydrophilic and hydrophobic substrates	6	Không	Thin Solid Films (ISSN: 0040-6090)	Q2, H-index: 184 - SCI IF: 1.888		698 , 137860	2020

25	Solution-Processed Cupric Oxide P-type Channel Thin-Film Transistors	6	Có	Thin Solid Films (ISSN: 0040-6090)	Q2, H-index: 184 - SCI IF: 1.888		704 , 137991	2020
26	Fabrication and Characterization of a Ferroelectric-Gate FET With a ITO/PZT/SRO/Pt Stacked Structure	5	Không	IEEE Proceedings of 22nd International Conference of Microelectronics, Cairo, Egypt (ISBN: 9781612841496)		5	, 32-35	2010
27	Lanthanum oxide capping layer for solution-processed ferroelectric-gate thin-film transistors	6	Không	MRS Symp. Proc. (ISBN: 9781618395719)			1337 , Q02-05	2011
28	Analysis on interface layer between Pt electrode and ferroelectric layer of solution-processed PZT capacitor	6	Không	MRS Symp. Proc. (ISBN: 9781618395719)		2	1368 , ww 08-11	2011
29	Thin film transistor fabricated by a precise alignment nano-imprinting lithography and physical dry-etching method	3	Có	Proceedings of The 4th International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA 2013), 14-16 Nov 2013, Vung Tau, Vietnam			, 743-745	2013

30	Huge on-current ferroelectric-gate thin film transistor with solution-processed indium tin oxide channel	3	Có	VNU Journal of Science: Mathematics-Physics (ISSN: 0866-8612)		1	30 , 16-23	2014
31	Thiết kế chế tạo hệ AP plasma lạnh sử dụng khí nitơ định hướng ứng dụng trong bảo quản hoa quả	7	Có	Proceeding of Advances in Applied and Engineering Physics (ISBN: 978-604-913-232-2)			, 246-251	2015
32	Study on ITO thin films prepared by multi-annealing technique	9	Có	Journal of Science and Technology (ISSN: 0866-708X)		1	54 , 1A, 136-142	2016
33	Investigation of structural and ferroelectric properties of Bi _{3.25} La _{0.75} Ti ₃ O ₁₂ thin film	9	Có	Journal of Science and Technology (ISSN: 0866-708X)			54 , 1A, 80-87	2016
34	Epitaxial-like growth of solution-processed PbZr _{0.4} Ti _{0.6} O ₃ thin film on single-crystal Nb-doped SrTiO ₃ substrate	2	Có	VNU Journal of Science: Mathematics-Physics (ISSN: 0866-8612)			33 , 36-44	2017
35	Conductive-perovskite LaNiO ₃ thin films prepared by using solution process for electrode application	2	Có	VNU Journal of Science: Mathematics-Physics (ISSN: 0866-8612)		1	34 , 29-35	2018

3	“Ferroelectric memory driving method and ferroelectric memory”	Japan Patent	04/09/2008	Đồng tác giả	2
---	--	--------------	------------	--------------	---

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 1 2 3

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế:

TT	Tên giải thưởng	Cơ quan/tổ chức ra quyết định	Số quyết định và ngày, tháng, năm	Số tác giả
Không có				

- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Cấp quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ	Vai trò	Cơ sở giáo dục đại học
1	Xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Việt Nhật	Tham gia	Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ☐; 04 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

(*) Các công trình khoa học thay thế không được tính vào tổng điểm.

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)